

### Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский

университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

## Отчет по лабораторной работе №6

# «Ключ на биполярном транзисторе»

Студент:	Платонова Марина Иго	ревна
Группа:	ИУ7-31Б	
Вариант:	92	
Название предприятия НУК ИУ МГТУ им. Н. Э. Баумана		
Студ	дент	Платонова М.И.
Прег	подаватель	<u>Оглоблин Д.И.</u>
Оце	нка	

#### Добавим транзистор из варианта в базу:

```
.model KT814v PNP(Is=11.45f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=72.62 Bf=150 Ise=97.57f + Ne=1.421 Ikf=.2157 Nk=.4096 Xtb=1.5 Br=1.928 Isc=637.6f Nc=1.41 + Ikr=.5927 Rc=.2979 Rb=4 Cjc=88.73p Mjc=.3333 Vjc=.75 Fc=.5 + Cje=71.14p Mje=.3333 Vje=.75 Tr=2.046u Tf=26.36n Itf=3 Xtf=5 Vtf=10)
```

## Эксперимент 4

Рассчитаем сопротивление базы для насыщения с коэффициентом 1:

Rk := 300

Ek := 5

U := 5

B := 150

$$S_{h} := 1$$

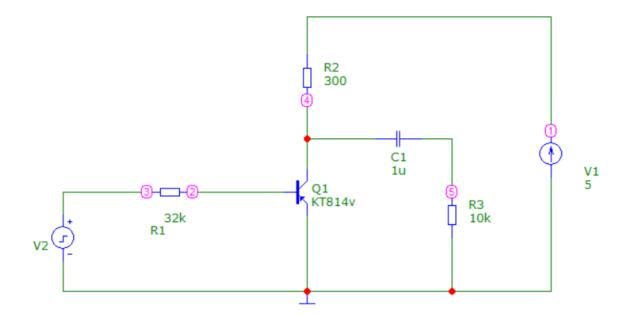
Ub := 0.7

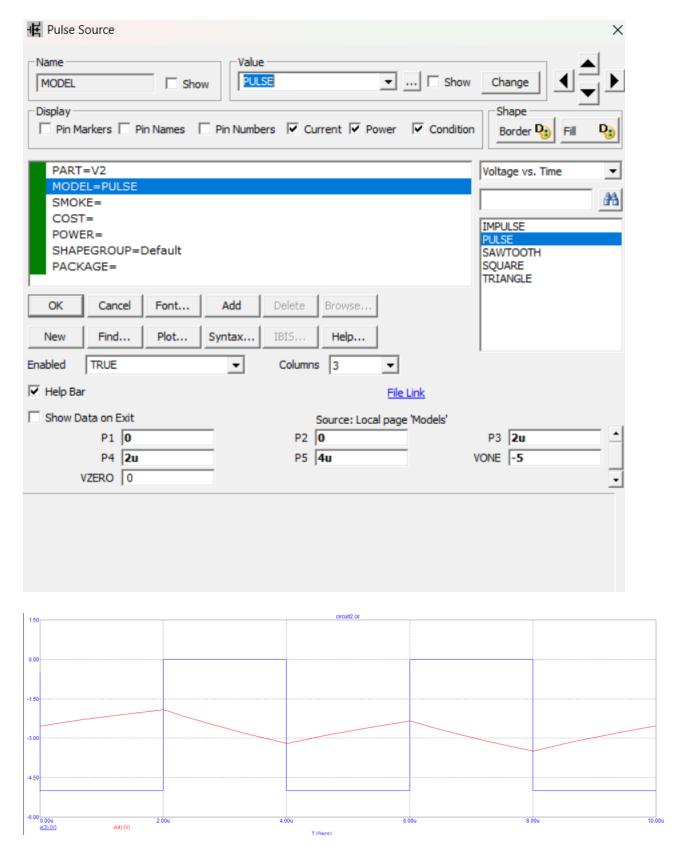
Uk := 0.2

Ikn :=  $\frac{(Ek - Uk)}{Rk} = 0.016$ 

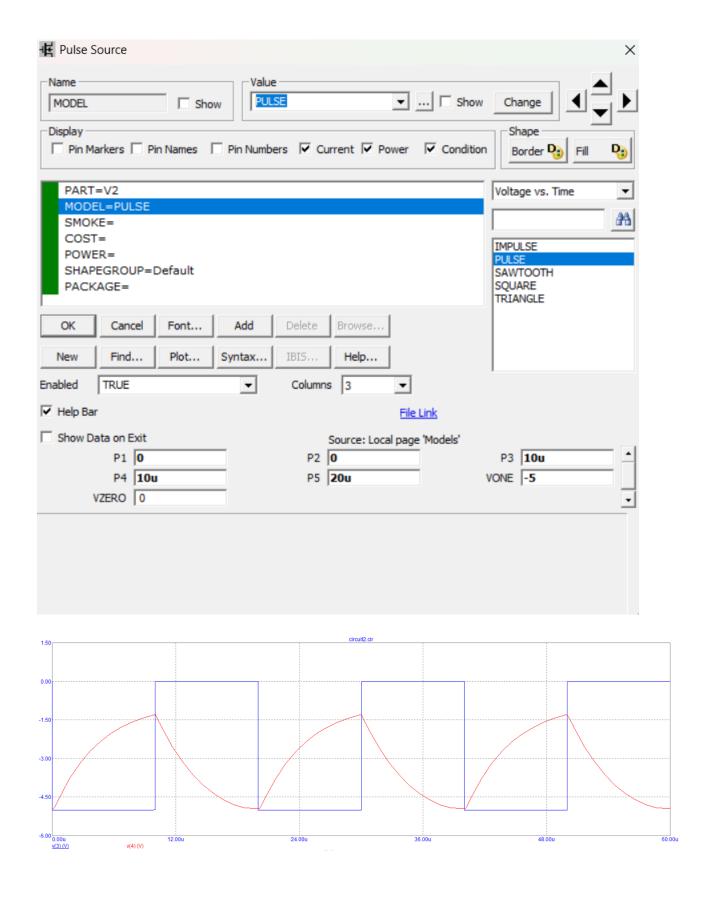
Ib :=  $\frac{Ikn}{B \cdot 0.8} = 1.333 \times 10^{-4}$ 
 $Rb := \frac{(U - Ub)}{S \cdot Ib} = 3.225 \times 10^{4}$ 

Составим схему с генератором импульсов и рассчитанным сопротивлением базы:



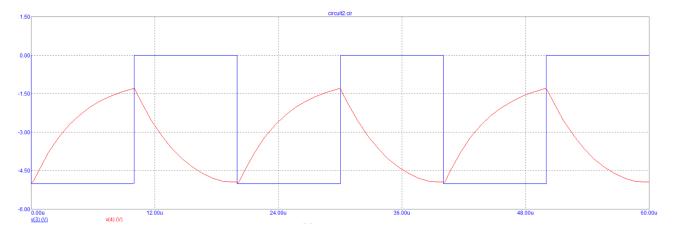


Как видно транзистор не успевает реагировать, так что увеличим длительность импульса:

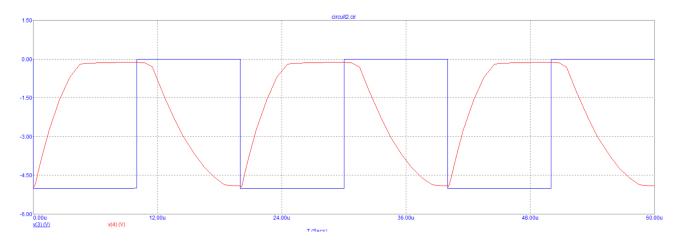


Исследуем графики при разных степенях насыщения:

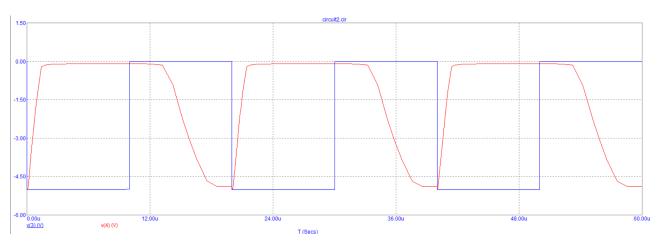
$$S = 1, Rb = 32k$$



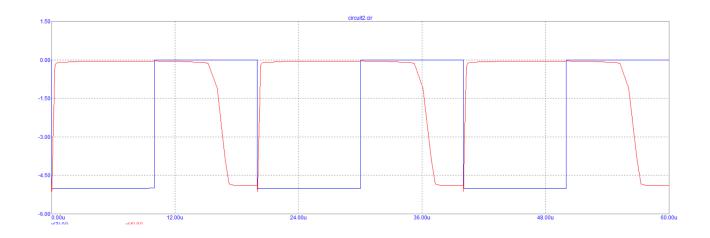
#### S=2 Rb=16k



#### S=5 Rb = 6.4k



S=20 Rb=1.6k

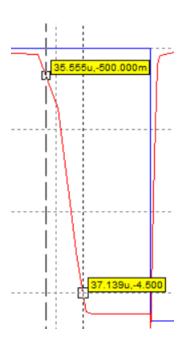


Рассмотрим длительности фронтов при насыщении S=20:

## Передний фронт



Задний фронт

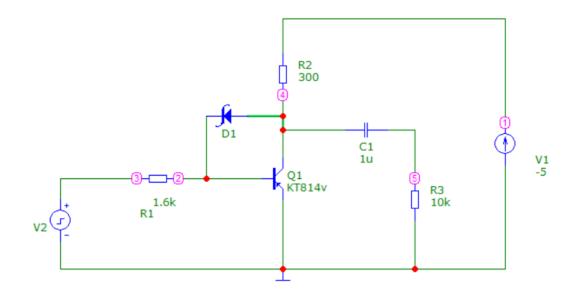


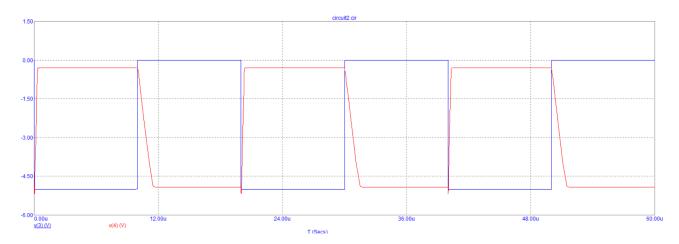
### Длительности:

Передний: 0.245 мкс

Задний: 1.584мкс

## Добавим в схему диод Шотке:

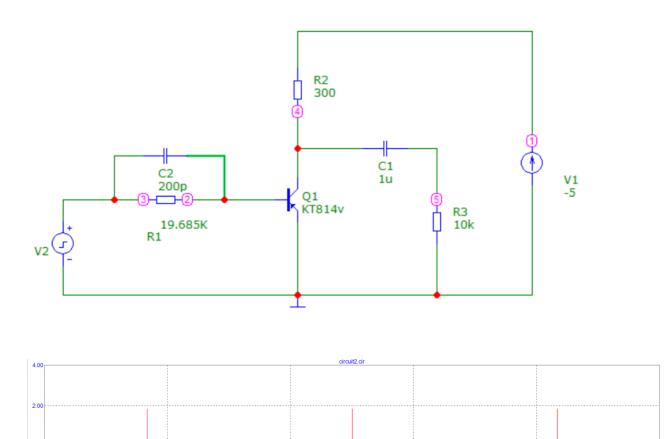




Как видно, диод шотке сократил время рассасывания.

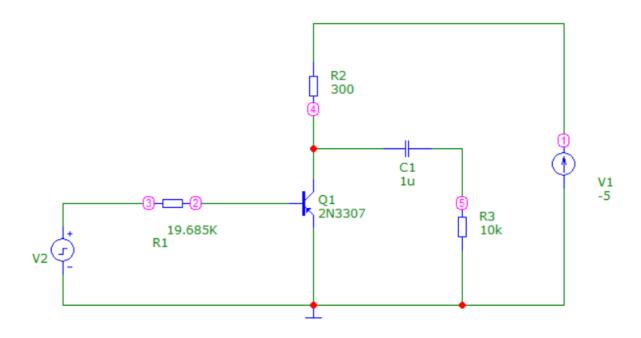
# Эксперимент 5

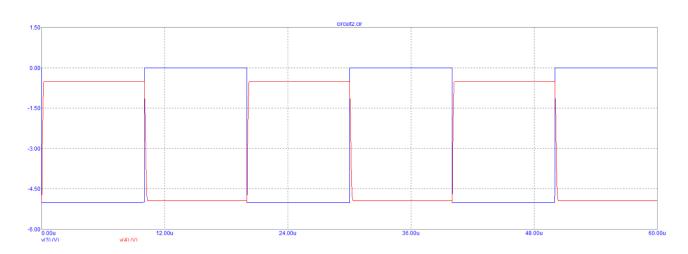
Экспериментальным путем подберем значения емкости и сопротивления для оптимальной работы транзистора в режиме ключа:



Подобранные значения: C=200 пф, R=19.685Ком.

Поменяем транзистор на случайный pnp:

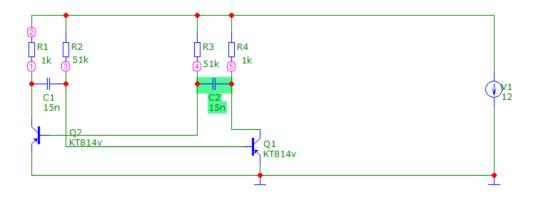


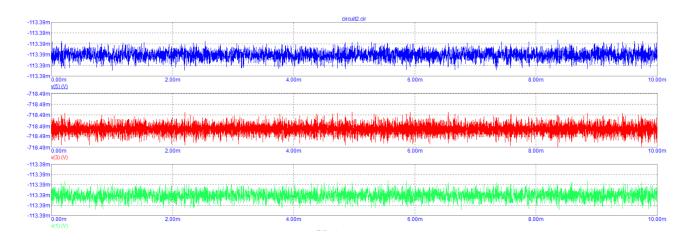


Как видно с данным транзистором инвертирование ближе к идеальному, значит от параметров транзистора зависит его эффективность в частности BF и CJC(у данного транзистора BF >200 и CJC<20р).

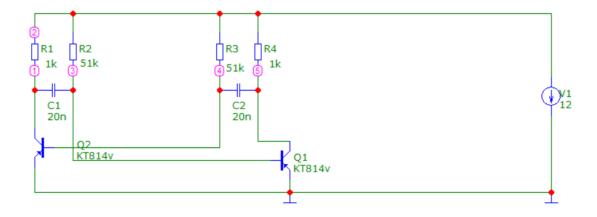
# Эксперимент 6

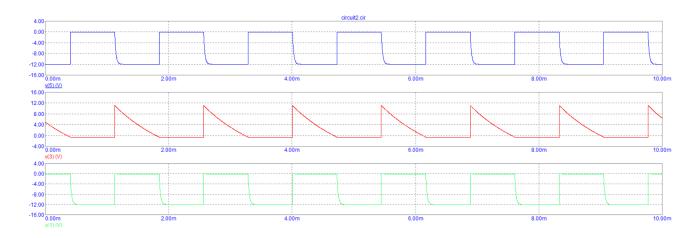
Соберем мультивибратор и рассмотрим полученные сигналы:





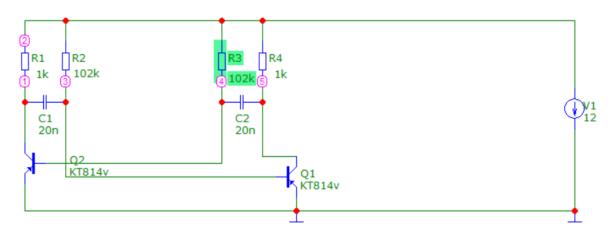
Полученные напряжения выглядят хаотично, видимо транзисторы не успевают реагировать. Попробуем увеличить константу времени с помощью емкости:



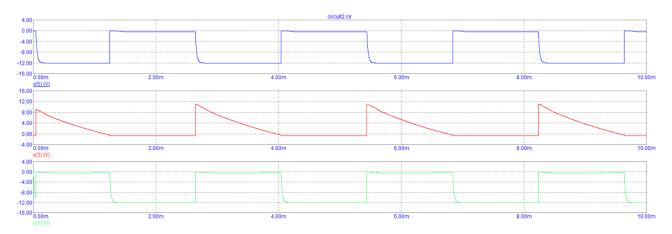


Теперь сигналы выглядят корректно. Длительность сигнала: 0.73мс

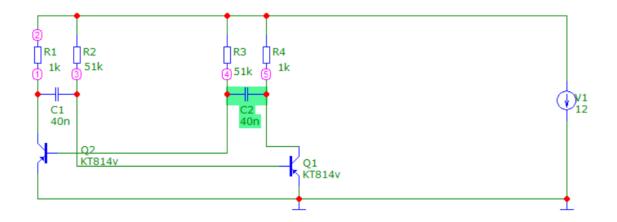
Изменим константы времени увеличив сопротивления в два раза.



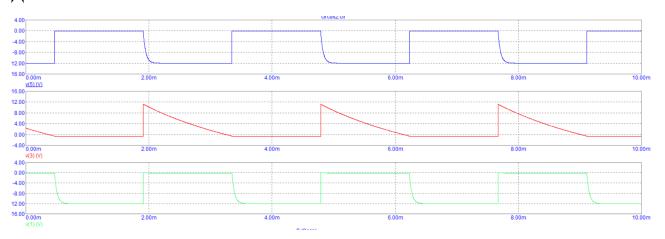
Длительность сигнала: 1.41 мс



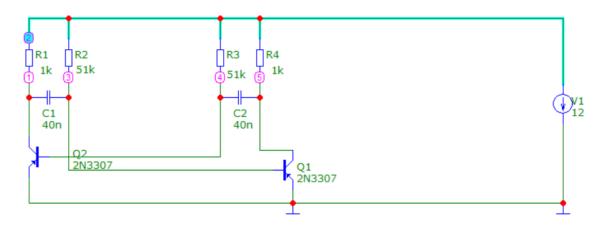
Возвращаем резисторы и увеличиваем в два раза емкости.



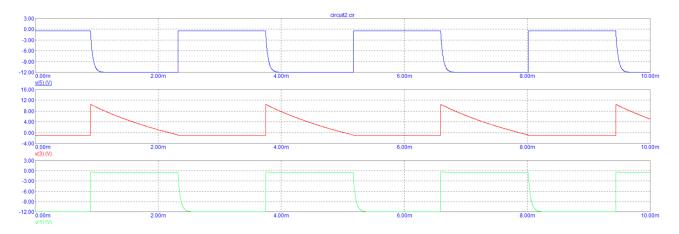
#### Длительность сигнала: 1.46 мс



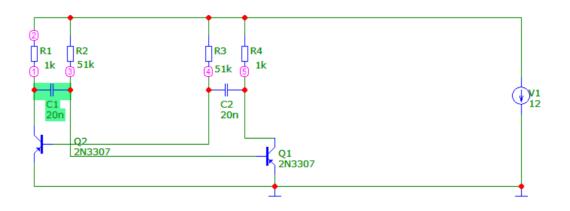
### Меняем транзистор:



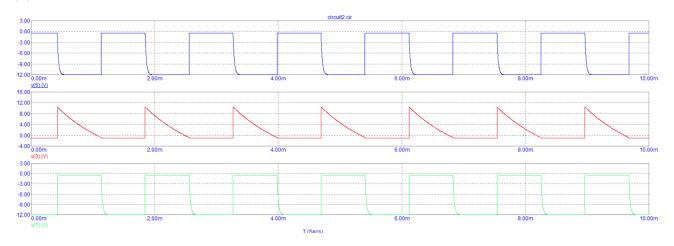
Длительность сигнала: 1.5 мс



Возвращаем исходные емкости:



Длительность сигнала: 0,75 мс



## Контрольные вопросы

Какие элементы имеют основное влияние на частоту мультивибратора?
 На частоту влияют хар-ки транзистора и постоянная времени RC.

2. Как влияет замена транзистора на параметры колебания?

Период колебаний зависит от паразитной емкости транзистора, чем ниже эта емкость, тем ниже и период.

3. Чем отличается работа математической модели мультивибратора от реального устройства?

Математические модели мультивибратора отличаются от реальных необходимостью введения разбаланса в плечах для возникновения колебаний (в редакторе начальных условий).